

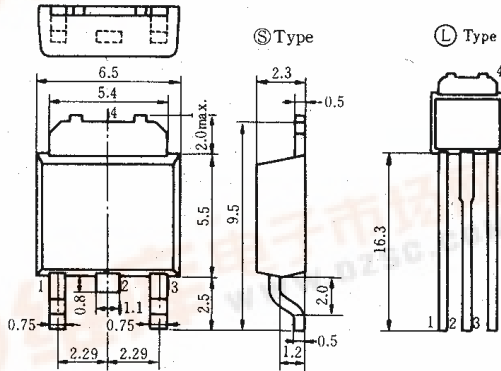
# 2SK579L, 2SK580L, 2SK579S, 2SK580S

查询2SK579供应商

捷多邦 专业PCB打样工厂, 24小时加急出货

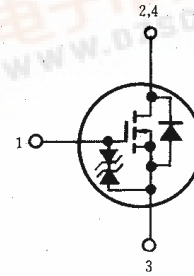
シリコン N チャンネル MOS FET  
高速度電力スイッチング用

SILICON N-CHANNEL MOS FET  
HIGH SPEED POWER SWITCHING



(DPAK)

1. ゲート: Gate
  2. ドレイン: Drain
  3. ソース: Source
  4. ドレイン: Drain
- (Dimensions in mm)



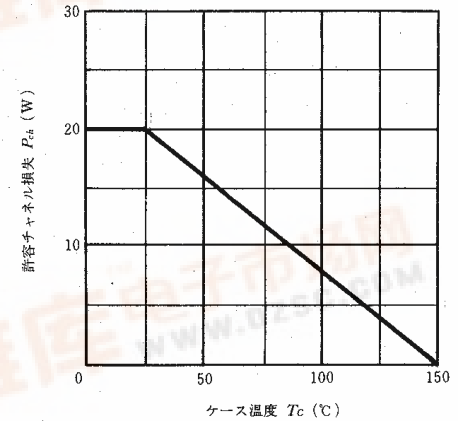
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SK579L, 2SK579S	2SK580L, 2SK580S	Unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DSS}$	450	500	V
ゲート・ソース電圧	$V_{GSS}$	$\pm 15$	$\pm 15$	V
ドレイン電流	$I_D$	1.5	1.5	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(pulse)^*}$	6	6	A
逆ドレイン電流	$I_{DR}$	1.5	1.5	A
許容チャンネル損失	$P_{ch}^{**}$	20	20	W
チャンネル温度	$T_{ch}$	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim +150$	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

- \* パルス幅 $\leq 10\mu\text{s}$ , デューティサイクル $\leq 1\%$
- \*  $PW \leq 10\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 1\%$
- \*\*  $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値
- \*\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

許容チャンネル損失のケース温度による変化  
MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION

CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	2SK579L, 2SK579S			2SK580L, 2SK580S			Unit
			min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=10\text{mA}$ , $V_{GS}=0$	450	—	—	500	—	—	V
ゲート・ソース破壊電圧	$V_{(BR)GSS}$	$I_G=\pm 100\mu\text{A}$ , $V_{DS}=0$	$\pm 15$	—	—	$\pm 15$	—	—	V
ゲート遮断電流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 12\text{V}$ , $V_{DS}=0$	—	—	$\pm 10$	—	—	$\pm 10$	$\mu\text{A}$
ドレイン電流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=360\text{V}$ , $V_{GS}=0$	—	—	100	—	—	—	$\mu\text{A}$
		$V_{DS}=400\text{V}$ , $V_{GS}=0$	—	—	—	—	—	100	$\mu\text{A}$
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	$I_D=1\text{mA}$ , $V_{DS}=10\text{V}$	2.0	—	4.0	2.0	—	4.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D=1\text{A}$ , $V_{GS}=10\text{V}^*$	—	3.5	5.5	—	4.0	6.0	$\Omega$
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=1\text{A}$ , $V_{DS}=20\text{V}^*$	0.6	1.0	—	0.6	1.0	—	S
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS}=10\text{V}$ , $V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$	—	260	—	—	260	—	pF
出力容量	$C_{oss}$		—	95	—	—	95	—	pF
逆伝達容量	$C_{rss}$		—	12	—	—	12	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	$I_D=1\text{A}$ , $V_{GS}=10\text{V}$ $R_L=30\Omega$	—	8	—	—	8	—	ns
立ち上がり時間	$t_r$		—	20	—	—	20	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	28	—	—	28	—	ns
下降時間	$t_f$		—	20	—	—	20	—	ns
フォワード順電圧	$V_{DF}$	$I_F=1.5\text{A}$ , $V_{GS}=0$	—	1.0	—	—	1.0	—	V
一回復時間	$t_{rr}$	$I_F=1.5\text{A}$ , $V_{GS}=0$ , $dI_F/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	—	250	—	—	250	—	ns

\* パルス測定  
\* Pulse Test

